

Высокотемпературное равновесие дефектов в монокристаллах сульфида цинка, легированных медью

Lott, Kalju; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : тезисы докладов Первой всесоюзной научно-технической конференций, МИСИС 1-4 февр. 1977 / с. 1976-1977

Высокотемпературное равновесие собственных и примесных (Cu, In) дефектов в монокристаллах

Õrik, Andres; Nirk, Tiit; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСИС 1-4 февр. 1977 / с. 129

Исследование взаимодействия собственных и примесных дефектов в монокристаллах сульфида кадмия

Aarna, Heiti; Voogne, Maie; Kukk, Peeter-Enn Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСИС 1-4 февраля 1977 / с. [126]

Исследование температурной зависимости растворимости меди и селениде цинка методами люминесценции

Kukk, Peeter-Enn; Rändur, Õie Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСИС 1-4 февраля ; Ч. 1 1977 / с. [?]

Поликристаллический селенид кадмия, легированный медью и хлором для изготовления таблеточных фоторезисторов

Varvas, Jüri; Tünn, Leo Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : тезисы докладов Первой всесоюзной научно-технической конференций, МИСИС 1-4 февр. ; Ч. 2 1977 / с. 181

Узкодисперсные порошки CdS и CdSe заданными гранулометрическими, морфологическими и электрофизическими свойствами

Mellikov, Enn; Hiie, Jaan; Altosaar, Mare; Varvas, Jüri Получение и свойства полупроводниковых соединений типа A II B VI и A IV B VI и твердых растворов на их основе : Тезисы докладов первой всесоюзной научно-технической конференции, МИСИС 1-4 февр. 1977 / с. 42-43